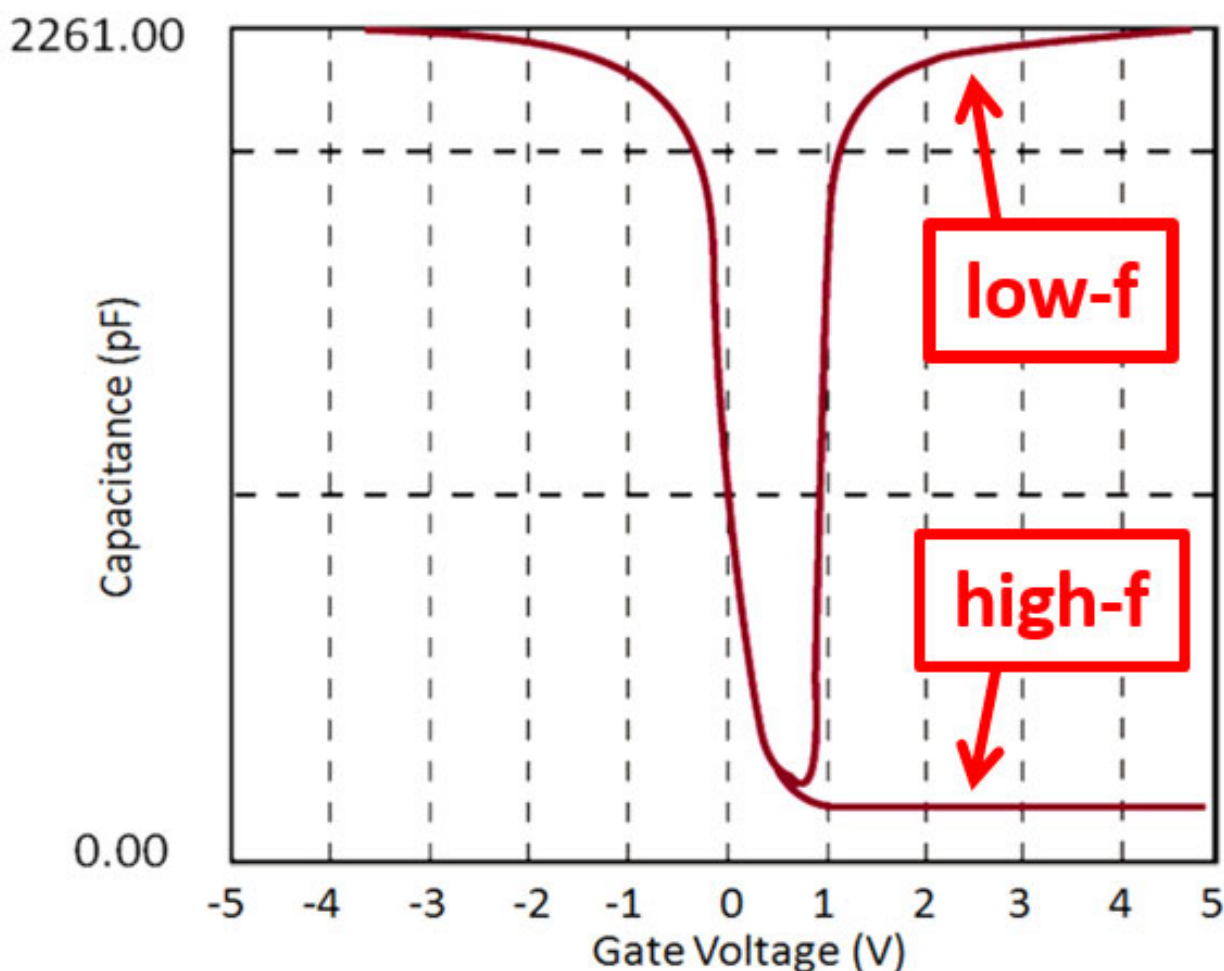


## Установка измерения электрических характеристик ртутным зондом MCV-530L



**Производитель:**

Semilab

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Установка MCV-530L позволяет избежать дорогостоящих процессов формирования контакта Шоттки, благодаря наличию безопасного и автоматизированного ртутного зонда с пневматическим управлением. Система имеет высоко воспроизводимую область контакта и использует только небольшое количество ртути для проведения воспроизводимых C-V и I-V измерений для разработки и контроля технологических процессов. В основном, метод измерения ртутным зондом (Mercury C-V) применяется для контроля электрических параметров диэлектрических (low-k, high-k диэлектрики) и эпитаксиальных слоев Si, SiC, GaAs, GaP, InP. Подходит для научно-

исследовательских разработок и мелкосерийного производства. Для производств с высокой степенью автоматизации доступны модели с автоматической загрузкой подложек из кассеты. **Доступны тестовые измерения образцов в лаборатории производителя.**

### **Измеряемые параметры:**

- профиль легирования эпитаксиального слоя,  $N(x)$
- профиль удельного сопротивления эпитаксиального слоя,  $\rho(x)$
- электрические параметры подзатворного диэлектрика ( $C_{ET}$ ,  $\epsilon_{OT}$ ,  $V_{FB}$ ,  $V_T$ ,  $Q_{EFF}$ ,  $k$   $D_{it}$ ) при C-V измерениях
- электрические параметры диэлектриков с высокой и низкой диэлектрической проницаемостью при I-V измерениях ( $I_L$ ,  $V_{BD}$ ,  $F_{BD}$ ,  $t_{BD}$ ,  $Q_{BD}$ ,  $V_{max}$ )